# 多孔質触媒への新規 MOFs 修飾法の確立と高水素含 有化合物からの水素生成反応への応用

兵庫県立大学工学研究科 准教授 野崎 安衣

#### 1. 緒言

化学産業界では省エネルギーかつ不要物 の削減を指向した持続可能なプロセスの構 築が求められている[1].そこで、本研究で は化学プロセスの省エネルギー化に欠くこ とのできない「触媒」調製とその調製過程に おける「不要物」の活用に着目した.

近年,多孔質材料を用いた触媒に関する 研究が多くなされており、その比表面積の 高さから高い触媒活性を示すことが期待で きる[2-8]. 特に, 多元系合金から調製した多 孔質金属触媒は優れた触媒特性を示すこと が知られている. 多孔質金属触媒は多元系 合金から脱合金化処理によって特定の元素 成分のみを溶出させることで得られ、母合 金よりも非常に高い触媒活性を示す.多孔 質金属触媒の中でも,多孔質 Au 触媒は特異 な性質を示し,特に低温酸化活性は他の貴 金属 (Pt, Ru) を凌ぐほど高活性を示すこと が報告されている[9,10]. 多孔質 Au 触媒は Au-Ag, Au-Cu 固溶体合金を濃硝酸で処理 することで Ag, Cu を選択的に溶出し調製 することができる[11,12]. 従来, Au 触媒は 6nm 以下のナノ粒子でなければ優れた触媒 特性を示さないが,多孔質 Au 触媒は 30 nm 以上のリガメントサイズでも優れた表面積 あたりの触媒活性を維持することから、そ の構造に由来した触媒特性が非常に注目さ

れている [11,12] .

多孔質 Au 調製において母合金から溶出 した Ag や Cu は触媒には利用されず, リサ イクルするにも多段階化によるエネルギー 負荷の増大が懸念される.この不要になる 金属 Ag や Cu を多孔質 Au の高活性化に活 用できないかと考え,溶出した金属を MOFs

(Metal Organic Frameworks:金属有機構造 体)の構成元素とすることに着想した. MOFs は,金属と有機配位子によって構成 される三次元多孔質材料であり,適切な構 成金属元素と有機配位子を選択することで, ガス貯蔵,ガス分離,触媒作用,薬物送達, または分子センシングの機能を付与するこ とができ,このような MOFs のもつ機能を 多孔質 Au に付加することで更なる高活性 化が期待できる[13].

本研究では、Au-Cu 合金から多孔質 Au 触 媒を調製し、その過程で溶出した Cu 元素を MOFs の構成元素として利用することで Cu-MOF 修飾多孔質 Au 触媒を調製する. また、触媒上への MOFs 修飾は従来、触媒 調製、MOFs 調製、MOFs 修飾と3段階のス テップを要するが、本研究では Au-Cu 合金 から1ステップでの Cu-MOFs 修飾多孔質 Au 触媒調製を試みる.

#### 2. 実験方法

2.1 Au-Cu 合金の作製

共沈法を用い HAuCl<sub>4</sub> 水溶液, CuCl<sub>2</sub> 水溶 液, 蒸留水を混合した後, KBH<sub>4</sub> を加え洗浄, 乾燥することで Au--Cu 合金を作製した.

2.2 多孔質 Au 触媒の調製

得られた Au-Cu 合金に HNO<sub>3</sub> 水溶液と DMF の混合溶液を用い脱合金処理を施す ことで,多孔質 Au 触媒を調製した. 硝酸 濃度が与える影響を明確にするため, Au-Cu 合金を異なる硝酸濃度(0.06, 1.0 wt%)の 溶液に浸漬させた試料を調製した. 調製し た多孔質 Au をそれぞれ porousAu(0.06), porousAu(1.0)と表記する.

2.3 Cu-MOF修飾多孔質Au触媒の調製

Au-Cu合金を出発原料としCu-MOF修飾 多孔質Au触媒の調製を行った.2.2で調製し た多孔質Auの脱合金処理溶液に有機配位子 を入れるというほぼ同様の調製手順でCu-MOF修飾多孔質Au触媒を調製した.調製し たCu-MOF修飾多孔質AuをCu-MOF/porous Auと表記する.

2.4 キャラクタリゼーションと触媒評価 触媒のキャラクタリゼーションとして、 走査型電子顕微鏡(FE-SEM)観察,エネル ギー分散型X線分析(EDX),X線高電子分

光法 (XPS) 測定, 赤外スペクトル (FT-IR) 測定, BET 法による比表面積測定を行った.

反応試験として,アンモニアボランから の水素生成反応を行った.

#### 結果および考察

3.1 多孔質 Au 触媒の調製

Au-Cu合金に脱合金処理を施し得られた 試料(porousAu)の表面形態についてFE-SEM 観察を行った. Fig. 1にはporousAu(0.06), porousAu(1.0)のSEM像を示した. どちらの試 料においても多孔質構造が観察され, 脱合 金処理によって微細な多孔質構造を有した 試料の調製ができた. 脱合金処理時の硝酸 濃度が低いporousAu(0.06)に比べ, 脱合金処 理時の硝酸濃度が高いporousAu(1.0)はより 粗大な構造を有していることがわかった.

作製した多孔質Auの脱合金処理時の硝酸 濃度,バルク組成比(EDX),表面組成比(XPS) をまとめたものをTable 1に示した. 組成測 定結果より,どちらの試料においても硝酸 処理をすることで前駆体合金(36 at%Cu)よ りも低いCu組成比を示し,硝酸処理によっ てCuが選択的に溶出したと考えられる. ま た,硝酸処理濃度を1.0 wt%とすることでよ り多くのCuが溶出された.

調製した多孔質Auを用いて4-メチルベン ジルアルコールの酸素酸化反応を行い硝酸 処理条件が触媒特性に与える影響について



**Fig. 1** SEM images of (a) porousAu(0.06), (b) porousAu(1.0).

**Table 1** The bulk and surface atomic ratiosof porousAu .

HNO <sub>3</sub>	Bulk		Surface	
concentr	atomic ratio		atomic ratio	
ation	/at%		/at%	
/wt%	Au	Cu	Au	Cu
0.06	89	11	85	15
1.0	95	5	96	4



**Fig.2** Conversion of 4-Methylbenzyl alcohol over Au-Cu alloy and porousAu(0.6), porousAu(1.0).

検討した. Fig. 2にはAu-Cu合金, porousAu (0.06), porousAu(1.0)上での反応時間24hにおける4-メチルベンジルアルコールの転化率を示した. Cuがほぼ残存しない多孔質Au(porousAu(1.0))よりもCuが残存した多孔質Au (porousAu(0.06))の方が高い活性を示すことが分かった.本研究で高活性を示したporousAu(0.06)表面にはCuが多く存在し、酸素酸化反応における活性点となり得るAu-CuO接合界面が多く存在したと考えられ、この結果、高い触媒活性が得られたと考えられの.

3.2 MOFs 修飾多孔質 Au 触媒の調製

Au-Cu合金から多孔質Au触媒を調製し, その過程で溶出したCu元素をMOFの構成 元素として利用することでCu-MOF修飾多 孔質Au触媒(Cu-MOF/porousAu)の調製を試 みた.Fig.3にはAu-Cu合金から得たCu-MOF修飾多孔質Au触媒(Cu-MOF/porousAu) のSEM観察結果を示す.Cu-MOF結晶と多孔 質Auが混在しており,Cu-MOFの一部を porousAuが覆うような構造が観察された.

調製した試料をアンモニアボランから の水素生成反応に応用したところ(Fig. 4), Cu-MOF/porousAuが高い水素生成量を示し た. 今後,構成金属や有機配位子を検討する ことで更なる高効率化が期待される.



Fig.3 SEM image of Cu-MOF/porousAu.



**Fig. 4** Evolved hydrogen from ammonia borane over the Cu-MOF/porousAu.

# 4. まとめ

本研究では、Au-Cu合金から調製したCu-MOF修飾多孔質金触媒の触媒特性を評価した.多孔質Auの触媒特性には残存したCuが 強く影響した.多孔質Auに比べCu-MOF修 飾多孔質Auはアンモニアボランからの水素 生成反応において高い水素生成量を示した.

### 謝辞

本研究は、公益財団法人 川西記念新明和 教育財団の助成を受けて行いました.ここ に厚く御礼申し上げます.

## 参考文献

[1] 土屋裕子,山野慎司,北川宏,グリーン・ サステイナブルケミカルプロセス基盤技術 開発/副生ガス高効率・分離精製プロセス基 盤技術開発, NEDO, 2014

[2] 山下弘巳,田中康裕,三宅孝典,西山覚,

古南博, 八尋秀典, 窪田好浩, 玉置純, 触媒・ 光触媒の科学入門, 講談社, 2006.

[3] K. Ariga, A. Vinu, Y. Yamauchi, Q. Ji, J. P. Hill, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2012, 85, 1.

[4] I. K. Mbaraka, K. J. McGuire, B. H. Shanks, Ind. Eng. Chem. Res., 2006, 45, 3022.

[5] M. Wen, Y. Kuwahara, K. Mori, D. Zhang,

H. Li, H. Yamashita, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14134.

[6] R. Weingarten, G. A. Tompsett, W. C. Conner Jr, G. W. Huber, J. Catal., 2011, 279, 174.

[7] M. Zhao, K. Deng, L. He, Y. Liu, G. Li, H. Zhao, Z. Tang, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 1738.

[8] M. Haruta, S. Tsubota, T. Kobayashi, H. Kageyama, M. J. Genet, B. Delmon, J. Catal., 1993, 144, 175.

[9] M. Haruta, M. Daté, Appl. Catal. A, 2001, 222, 427.

[10] T. Fujita, T. Tokunaga, L. Zhang, D. Li, L.

Chen, S. Arai, Y. Yamamoto, A. Hirata, N. Tanaka, Y. Ding, M. Chen, Nano Lett., 2014, 14, 1172.

[11] J. Zhang, P. Liu, H. Ma, Y. Ding, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 10382.

[12] S. Kitagawa, R. Kitaura, S. Noro Angew. Chem. Int. Ed. 2004,43 (18), 2334-2375.

[13] M. Haruta, N. Yamada, T. Kobayashi, Iijima, S. Iijima.J. Catal. 1989, 115, 301–309.